

Введение к циклу статей по методам и средствам оценки и прогнозирования радиационной стойкости изделий микроэлектроники

83

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ

Прогнозирование локальных радиационных эффектов в ИС при воздействии факторов космического пространства

*А. И. Чумаков, А. Л. Васильев, А. А. Козлов,
Д. О. Кольцов, А. В. Крицкий,
А.А. Печенкин, А. С. Тараксин, А. В. Яненко*

85

Особенности проектирования субмикронных КМОП статических ОЗУ с повышенной сбоеустойчивостью к воздействию высокоэнергетических частиц

В. Я. Стенин, И. Г. Черкасов

91

Конверсионная модель эффекта низкой интенсивности в биполярных микроэлектронных структурах при воздействии ионизирующего излучения

В. С. Першенков, Д. В. Савченков, А. С. Бакеренков, В. Н. Улимов

102

Методы построения КФП для прогнозирования функциональных отказов БИС при воздействии радиационных и электромагнитных излучений

В. М. Барбашов

113

Особенности стимулированного излучением пробоя $p-n$ -перехода с неоднородным легированием

А. С. Пузанов, С. В. Оболенский

126

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ СВЧ ДИАПАЗОНА

Исследование влияния ионизирующих излучений на характеристики кремний-германиевых интегральных схем СВЧ диапазона

В. В. Елесин, Г. В. Чуков, Д. В. Громов, В. В. Репин, В. А. Вавилов

136

Проектирование пассивных элементов для монокристаллических кремний-германиевых СВЧ ИС,
устойчивых к воздействию ионизирующих излучений

В. В. Елесин, Г. Н. Назарова, Н. А. Усачев

149

Вниманию авторов

158